герв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-
	ďoφ	30	И	0003114 101140	Tradifictiodaliac	K	чание
					Документация		
ерв. п					<u> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>		
	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 СБ	Сборочный чертеж		
	A 4			04 H0H I/D E00 +0 +1 00 04 07 0+	0		
H	A4			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э1	Схема электрическая		
	_				структурная		
Qı	A3			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э2	Схема электрическая		
Эправ. №	٨٧			0Ψ INOT NI 1102 10 11.00.0 1 01 02	функциональная		
SIIS					qcy:moqoremen:2::es:		
Ш	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 ЭЗ	Схема электрическая		
Ш					принципиальная		
	1.1			CA MOM VD FIOO 40 44 00 04 07 FIOO	Попочани опомонию		
	<u>A4</u>			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 ПЭ3	Перечень элементов		
na					Детали		
u dan					<u> </u>		
100П. (A3		1	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07	Плата печатная	1	
					//a		
дубл.			2		Конденсаторы 0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	18	C5C12
Инв. № оубл.					0000-X7N-30 D-0,1 MK4±10/6	10	C13C18
	_						C21C24
Взам. инв. №							C28
33aM.			3		0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10%	1	C26
Ħ	_		4		0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	C27
dam			5		1206-X5R-10 B-47 мкФ±20%	1	C29
Іобп. и дата							07
7	изм лист № оокум. 1100п. дата СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.0					.04	0/
100 <i>1</i> 1.	Pa	зра 0в.	6 . H	авловская В.А		J lucn	n Jlucmoe 3
ИНВ. № ПООЛ.	н.контр.			Цифро	овой автомат		
ИН	<u>У</u> п					мат	A4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		6		TECAP-A-50 B-1 μκΦ±10%	8	C1C4,C12
						C19,C20 C25
				Микросхемы		
		7		533ЛH1 (401.14 - 5)	1	DD2
		8		74HC40510 (TS0P-16)	3	DD3,DD5
				12-22 ((22)2 2 ()		DD7
		9		AD7824 (SOIC-24)	1	DA3
		10		AD8561 (SOIC-8)	2	DA6,DA7
		11		INA118E_BB (SOIC-8)		DA4,DA5
		12		MC74ACT08DG (SOÍC-14)	3	DD1,DD4
		40		0.D.A.V.000 (0.0.T. 0.0)		DD6
		13		0PAX333 (S0T-23)	2	DA1,DA2
				Резисторы		
		14		0805-0.125 Bm-0 Ом ±1%	1	R23
		15		0805-0.125 Bm-4.7 Om ±1%	1	R5
		16		0805-0.125 Bm-56 Ом ±1%	1	R18
		17		0805-0.125 Bm-200 Ом ±1%	1	R2
		18		0805-0.125 Bm-330 Om ±1%	1	R7
		19		0805-0.125 Bm-470 Ом ±1%	1	R3
		20		0805-0.125 Bm-1 кОм ±1%	1	R16
		21		0805-0.125 Bm-1.5 кОм ±1%	1	R10
		22		0805-0.125 Bm-2 кОм ±1%	1	R6,R9
		23		0805-0.125 Bm-2.2 кОм ±1%	1	R17
\dashv		24		0805-0.125 Bm-3 кОм ±1%	1	R1
		25		0805-0.125 Bm-7.5 кОм ±1%	1	R15
		26		0805-0.125 Bm-8.2 кОм ±1%	1	R11
		27		0805-0.125 Bm-10 кОм ±1%		R4,R8
		·				R19R22
		28		0805-0.125 Bm-51 κ0м ±1%	1	R14
			CW 1/12	и КР ПЭ2-18 11.03.0		Лист
VI3M	. JIUC	cm	№ оокум. Пооп. Дата Копиров		4 С мат)/ 2 A4

ине. № поол. 💎 1 100п. и дата 🏻 Взам. ине. № јине. № дубл. 💎 1 100п. и дата

Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
	29		0805-0.125 Bm-160 кОм ±1%	1	R13
+	30		0805-0.125 Bm-200 κ0M ±1%	1	R12
	30		0000-0.123 DITI-200 KUNI ±1 /0		NIZ
			Соединения контактные		
	31		CI1102M1H	2	XS2,XS
	32		CI1103M1H	1	XS3
	33		CI1104M1H	1	XS4
	34		CI1110M1H	1	XS1
			Транзисторы		
	35		NTF2955T1G	1	VT2
	36		SI2304DDS-TI-GE3	1	VT1
	37		Устройство коммутационное	4	SB1SE
			IT-1187USMD	•	05102
/13M. J IU	ıcm № oc	окум. Пооп. Дата	<mark>ЮИ КР ПЭ2-</mark> 18 11.03.0	4 ($\frac{\sqrt{3}}{3}$

Копировал

1100п. и дата 📗 Взам. ине. № 🏻 Ине. № дурл. 📗 1100п. и дата

Формат А4